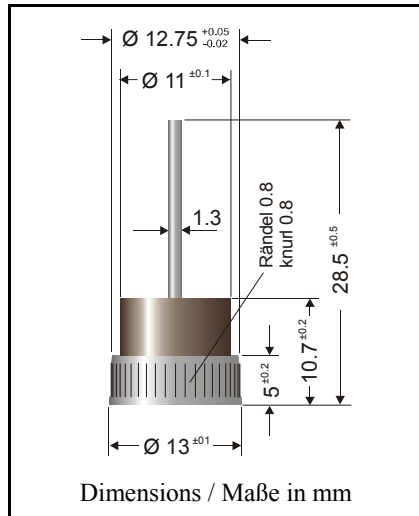


**Silicon Protectifiers
with TVS characteristics
High-temperature diodes**

**Silizium Schutzgleichrichter
mit Begrenzereigenschaften
Hochtemperaturdioden**



Nominal current – Nennstrom 35 A

Nominal breakdown voltage 19.8 ... 51.7 V
Nominale Abbruch-Spannung

Metal press-fit case with plastic cover
Metall-Einpreßgehäuse mit Plastik-Abdeckung

Weight approx. – Gewicht ca. 10 g

Casting compound has UL classification 94V-0
Vergußmasse UL94V-0 klassifiziert

Standard packaging: bulk
Standard Lieferform: lose im Karton

Maximum ratings

Grenzwerte

Type / Typ Wire to / Draht an		Breakdown voltage Abbruch-Spannung $I_T = 100 \text{ mA}$ $V_{BRmin} \text{ [V]} \quad V_{BRmax}$		Reverse voltage Sperrspannung $I_R = 5 \mu\text{A}$ $V_R \text{ [V]}$	Max. clamping voltage Max. Begrenzerspannung. at / bei $I_{PP}, t_p = 1 \text{ ms}$ $V_C \text{ [V]} \quad I_{PP} \text{ [A]}$	
Anode	Cathode					
BYZ 35A22	BYZ 35K22	19.8	24.2	> 17.8	31,9	161
BYZ 35A27	BYZ 35K27	24.3	29.7	> 21.8	39,1	128
BYZ 35A33	BYZ 35K33	29.7	36.3	> 26.8	47,7	106
BYZ 35A39	BYZ 35K39	35.1	42.9	> 31.6	56,4	89
BYZ 35A47	BYZ 35K47	42.3	51.7	> 38.1	67,8	75

Max. average forward rectified current, R-load $T_C = 150^\circ\text{C}$ I_{FAV} 35 A
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last

Peak forward surge current, 50 / 60 Hz half sine-wave $T_A = 25^\circ\text{C}$ I_{FSM} 360 / 400 A
Stoßstrom für eine 50 / 60 Hz Sinus-Halbwellen

Rating for fusing, $t < 10 \text{ ms}$ $T_A = 25^\circ\text{C}$ i^2t 660 A²s
Grenzlastintegral, $t < 10 \text{ ms}$

Forward voltage $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 35 \text{ A}$ V_F < 1.1 V
Durchlaßspannung

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur T_J – 50...+215°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur T_S – 50...+215°C

Max. junction temperature in case of "Load Dump"
Max. Sperrschichttemperatur bei "Load Dump"

T_{jmax} +280°C

Thermal resistance junction to case
Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse

R_{thC} < 0.8 K/W

Maximum pressure – Maximaler Einpreßdruck

7 kN

